

Кремниевый PIN фотодиод 6 мм, ТО-корпус — техническое описание

P/N : WST8-08A

ОСОБЕННОСТИ

Высокая чувствительность
Низкий темновой ток; низкая емкость

ПРИМЕНЕНИЕ

Лазерное прицеливание, наведение, сопровождение и разведка
Лазерное микропозиционирование, контроль перемещений и другие прецизионные измерительные системы

Электрооптические характеристики (T=25 °C)

Параметр	Обозначение	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Условия измерения
Рабочий диапазон длин волн	λ		400~1100		нм	—
Пиковая длина волны	λс		980		нм	—
Активная область	Ф		6.0		мм	—
Чувствительность	Re	0.45	0.5	0.65	А/Вт	λ=900nm, VR=15V
Прямое напряжение	Vf	—	—	0.7	В	If=1mA
Напряжение обратного смещения	Vbr	120	—	—	В	Id=10μA
Темновой ток	Id	—	2.0	10	нА	VR=15V
Емкость	Cpd	—	35	50	пФ	V=15V , f=1MHz

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Условия	Значения	Ед. изм.
Температура хранения	Tstg	—	-40~ +125	°C
Рабочая температура	Top	—	-40~ +85	°C
Время пайки	—	—	5	с
Температура пайки фотодиода	—	—	300	°C

Назначение выводов и габаритный чертёж:

Архитектура корпуса: TO-8

